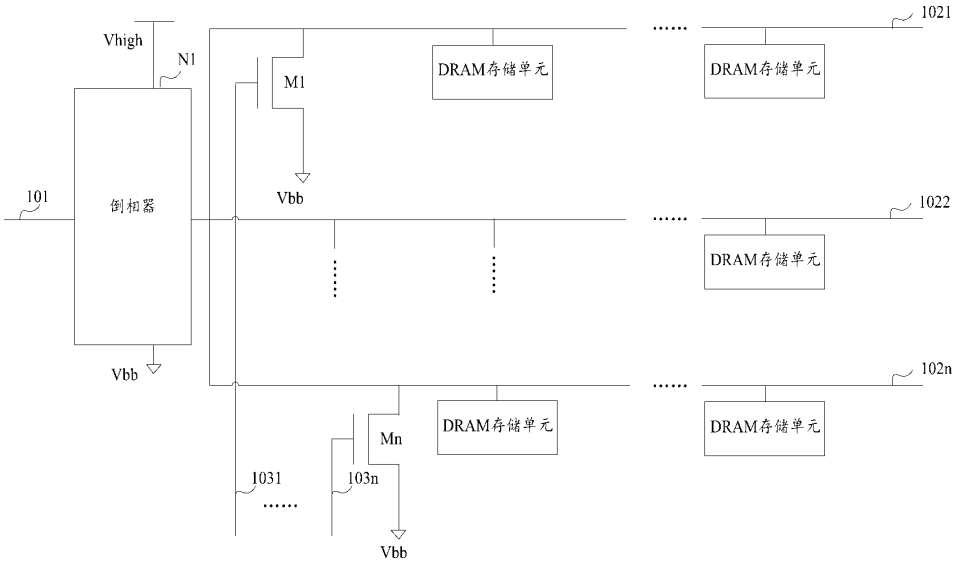
Vhigh
N1
M1
DRAM存储单元
1021
101
倒相器
Vbb
1022
102n
Mn
1031
103n

图 1

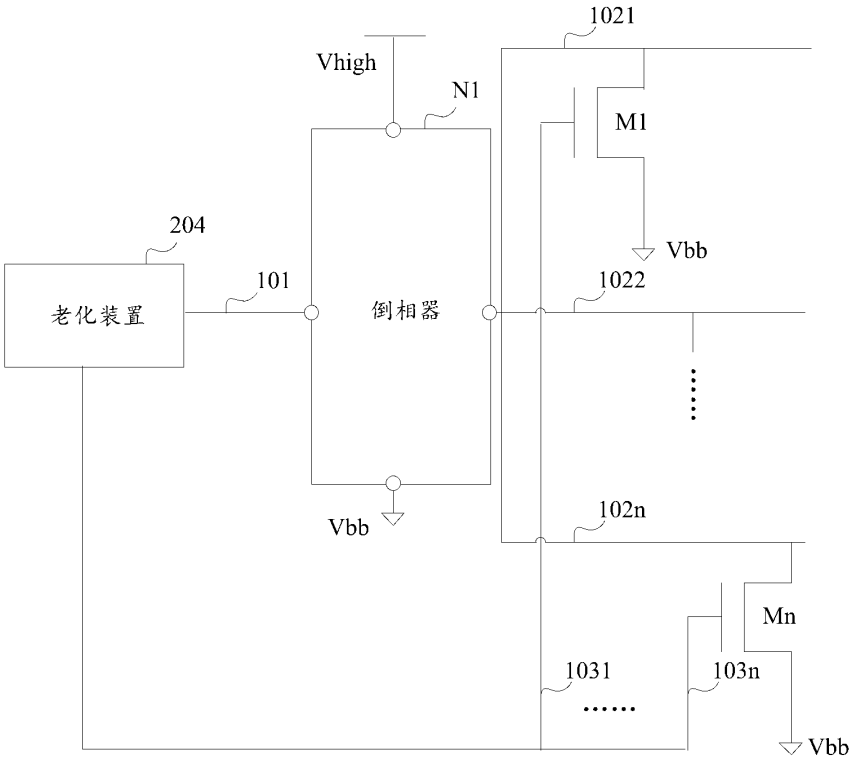
1021
Vhigh
N1
M1
204
Vbb
老化装置
101
倒相器
1022
102n
Mn
1031
103n

图 2

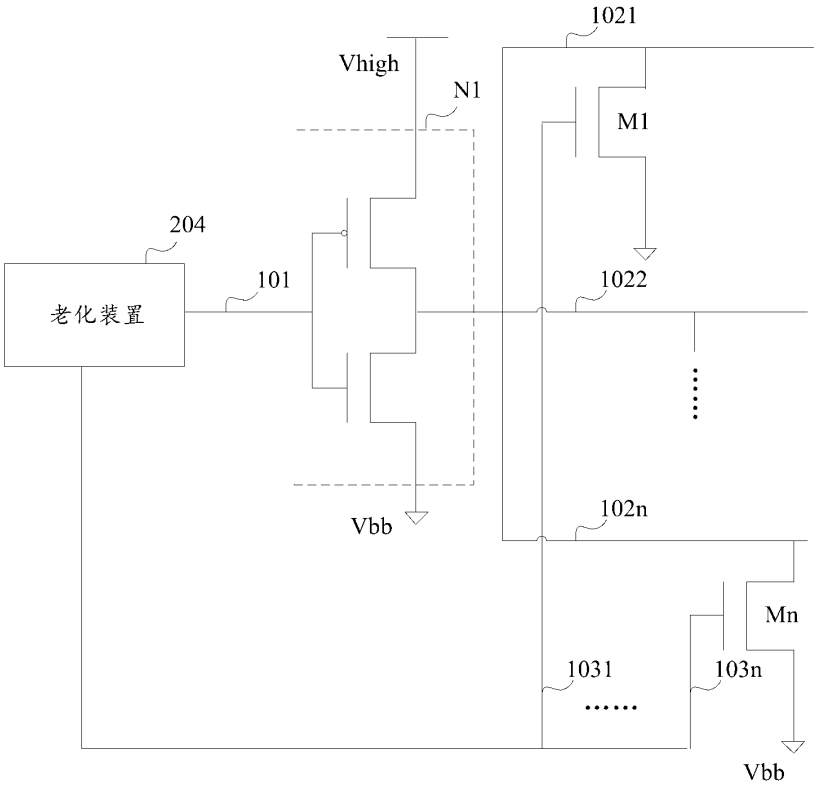

图 3

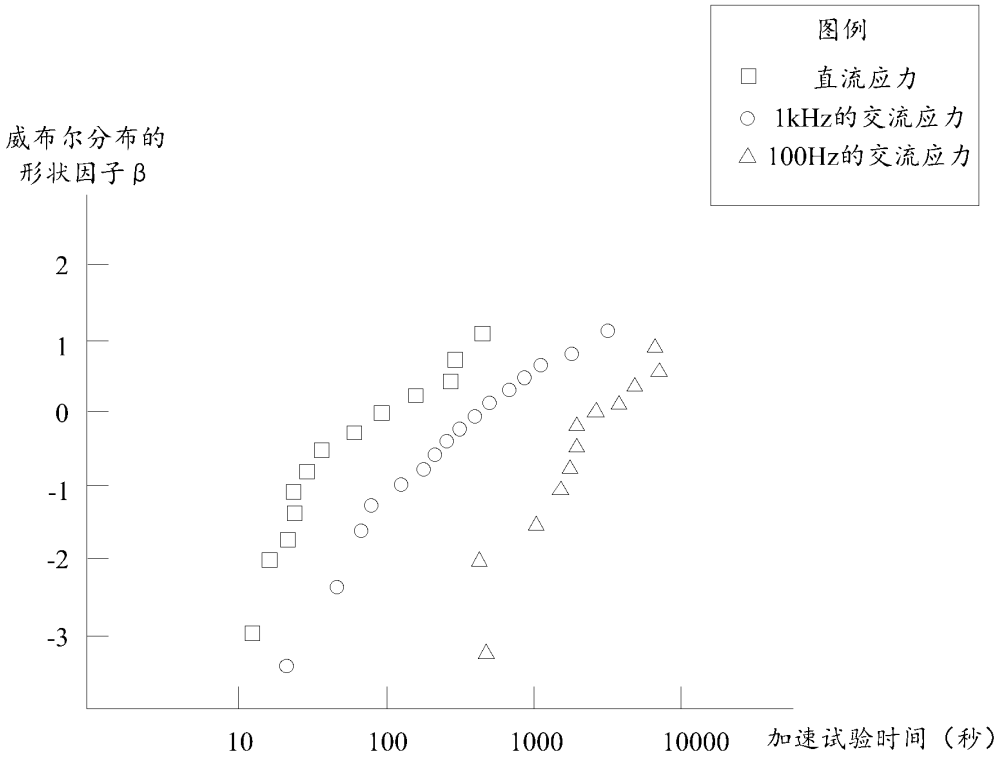
图例
□ 直流应力
○ 1kHz的交流应力
△ 100Hz的交流应力
威布尔分布的
形状因子β
2
1
0
-1
-2
-3
10
100
1000
10000
加速试验时间（秒）

图 4

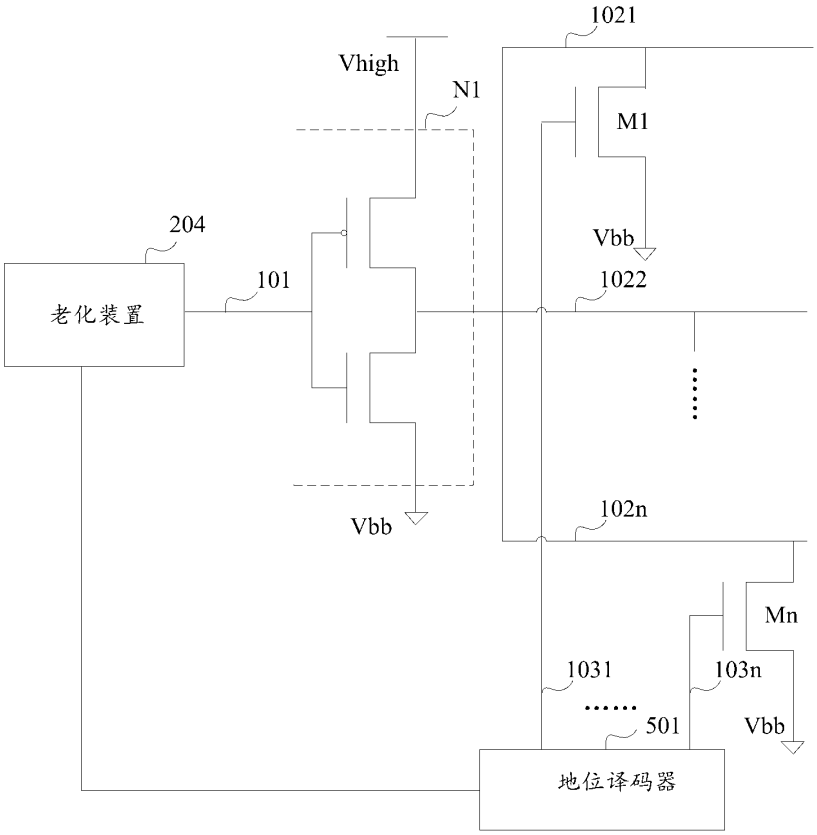
1021
Vhigh
N1
M1
204
Vbb
老化装置
101
1022
Vbb
102n
Mn
1031
103n
501
Vbb
地位译码器

图 5

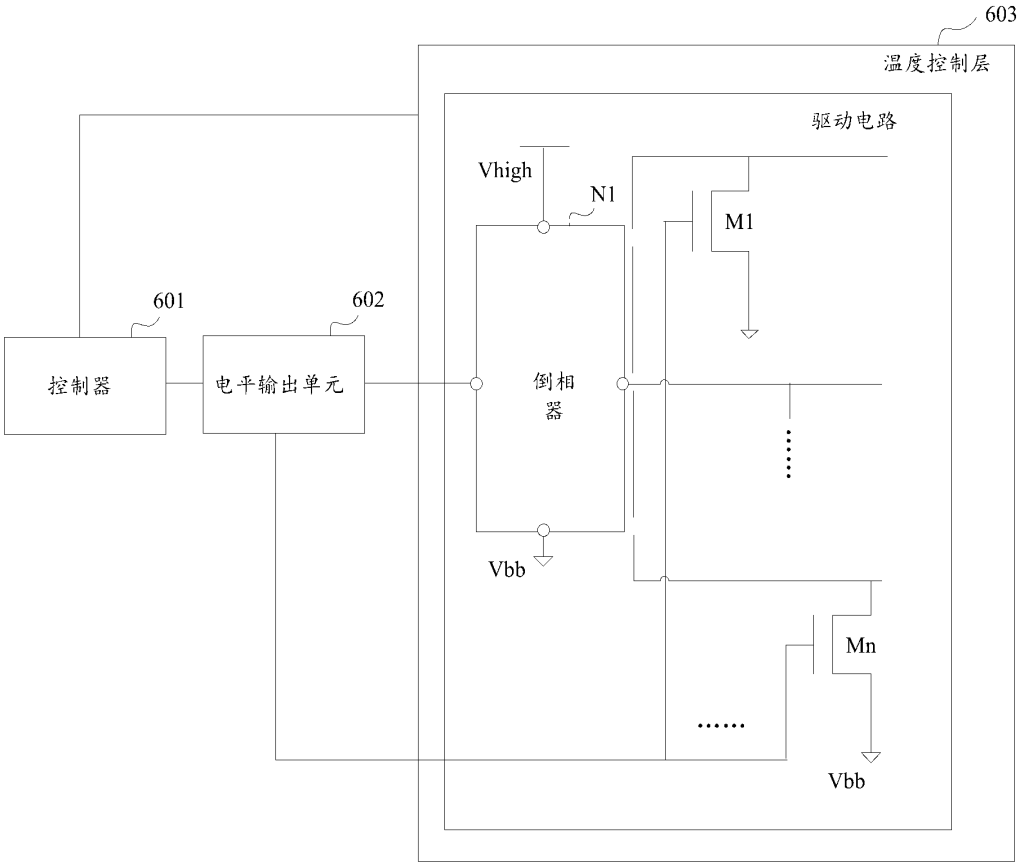

图 6

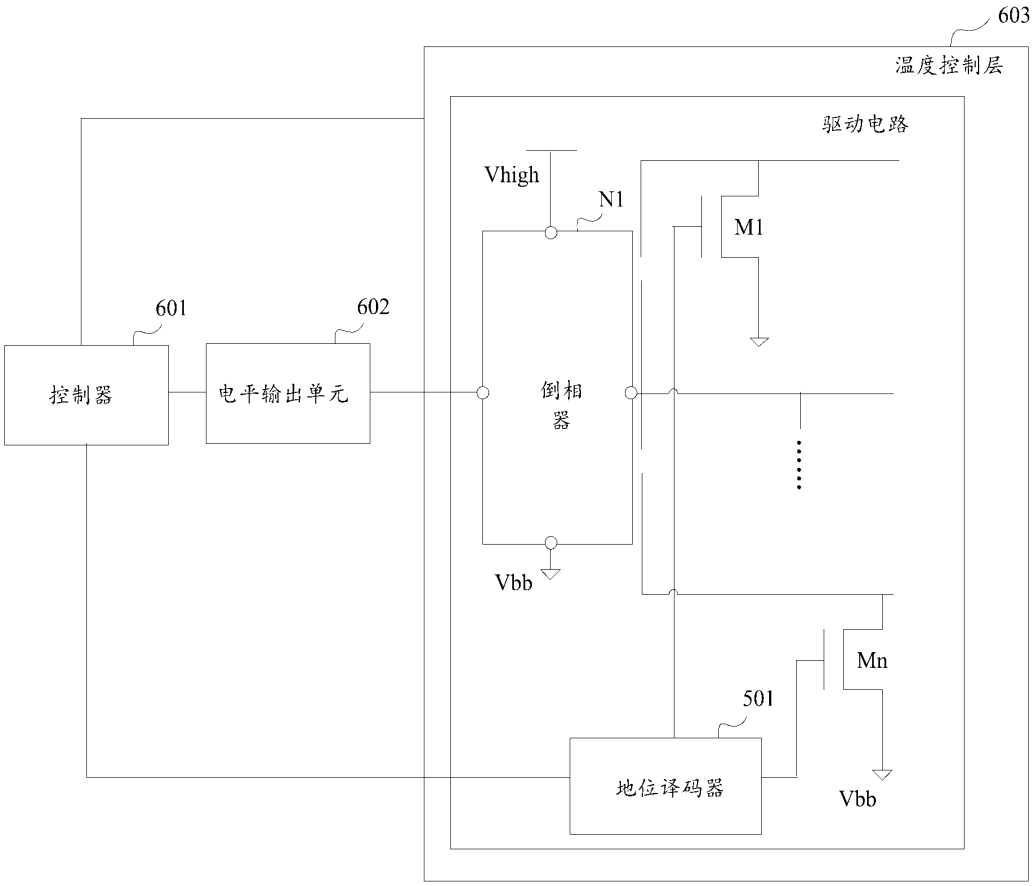
603
温度控制层
驱动电路
Vhigh
N1
M1
601
602
控制器
电平输出单元
倒相器
Vbb
Mn
501
地位译码器
Vbb

图 7

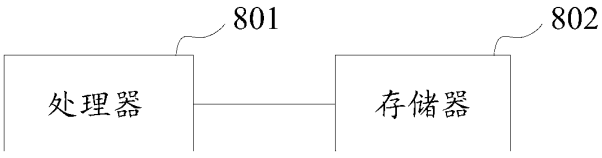
801
802
处理器
存储器

图 8